

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753
ルネサス エレクトロニクス株式会社
問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>
E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A109A/J	Rev.	第1版
題名	RX111グループフラッシュメモリに関するユーザーズマニュアルの誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	RX111グループ	対象ロット等	関連資料	RX111グループ ユーザーズマニュアルハードウェア編 Rev.1.10 (R01UH0365JJ0110) RX111グループ 製品改訂に伴う仕様の変更について (TN-RX*-A132A/J)	
		全ロット			

RX111グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10の「35. フラッシュメモリ」章において誤記がありましたので、以下のとおり訂正いたします。

〈訂正内容〉

• Page 1096 of 1244

「表35.1 フラッシュメモリの仕様」のソフトウェアコマンド欄を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

表35.1 フラッシュメモリの仕様

項目	内容
メモリ空間	<ul style="list-style-type: none"> ユーザ領域: 最大128Kバイト データ領域: 8Kバイト
ソフトウェアコマンド	<ul style="list-style-type: none"> ブートモードおよびセルフプログラミング時に以下を実行可能 ブランクチェック、ブロックイレース、プログラム、リード、アクセスウィンドウの設定 上記に加えブートモード時はチェックサムを、セルフプログラミング時はサスペンド/レジュームを実行可能
(省略)	

【訂正後】

表35.1 フラッシュメモリの仕様

項目	内容
メモリ空間	<ul style="list-style-type: none"> ユーザ領域: 最大128Kバイト データ領域: 8Kバイト エクストラ領域: スタートアップ領域情報、アクセスウィンドウ情報、ユニークIDを格納
ソフトウェアコマンド	<ul style="list-style-type: none"> 以下のソフトウェアコマンドを実装 プログラム、ブランクチェック、ブロックイレース、ユニークIDリード エクストラ領域のプログラム用に以下のコマンドを実装 スタートアップ領域情報プログラム、アクセスウィンドウ情報プログラム
(省略)	

• Page 1100 of 1244

「35.4.2 フラッシュP/Eモードエントリレジスタ(FENTRYR)」の本文1行目を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

ROMやE2データフラッシュを書き換えるためには、FRNTRYD, FENTRY0ビットのいずれかのビットを“1”にしてP/Eモードに移行させる必要があります。

【訂正後】

ROMやE2データフラッシュを書き換えるためには、FRNTRYD, FENTRY0ビットのいずれかのビットを“1”にしてP/Eモードに移行させる必要があります。

• Page 1100 of 1244

「35.4.2 フラッシュP/Eモードエントリレジスタ(FENTRYR)」のFENTRY0ビット、FENTRYDビットの「“0”になる条件」を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

- バイトアクセスで書いた場合
- FEKEY[7:0]ビットを“AAh”以外にしてFENTRYRレジスタに書いた場合
- FENTRYRレジスタに“AA00h”を書いた場合
- FENTRYRレジスタが“0000h”以外の状態で、FENTRYRレジスタに書いた場合

【訂正後】

- FENTRYRレジスタに“AA00h”を書いた場合

• Page 1106 of 1244

「35.4.9 フラッシュ制御レジスタ(FCR)」の「ブロックイレース」の説明文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

- フラッシュメモリの1ブロックの消去を行います。
FSARH/FSARLレジスタには消去対象ブロックの先頭アドレスを、FEARH/FEARLレジスタには同一ブロックの最終アドレスを設定してください。それ以外の設定をした場合、消去が正しく行えない場合があります。

【訂正後】

- フラッシュメモリ内の指定した1ブロックの消去を行います。
消去したいブロックの先頭アドレスと最終アドレスを、それぞれFSARH/FSARLレジスタとFEARH/FEARLレジスタに設定してください。それ以外の値を設定した場合、消去が正しく行えない場合があります。

• Page 1108 of 1244

「35.4.10 フラッシュエクストラ領域制御レジスタ (FEXCR)」の「アクセスウィンドウ情報プログラム」の説明文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

エリアプロテクションで使用するアクセスウィンドウを設定するために使用します。

アクセスウィンドウはブロック単位で設定します。

FWBH レジスタにアクセスウィンドウの先頭アドレスの **b19-b10** を、**FWBL** レジスタにアクセスウィンドウの最終アドレス+1の **b19-b10** を設定してこのコマンドを実行します。

なお、先頭アドレスと最終アドレスを同じ値に設定した場合、全領域がアクセス可能になります。また、先頭アドレスが最終アドレスより大きい値を設定しないでください。

【訂正後】

エリアプロテクションで使用するアクセスウィンドウを設定するために使用します。

アクセスウィンドウはブロック単位で設定します。

FWBL レジスタにアクセスウィンドウの先頭アドレス(アクセスウィンドウ開始アドレス)を、**FWBH** レジスタにアクセスウィンドウの最終アドレスの次のアドレス(アクセスウィンドウ終了アドレス)を指定してこのコマンドを発行します。各レジスタにはプログラム/イレーズ用アドレスの**b19-b10**を設定してください。

なお、開始アドレスと終了アドレスに同じ値を指定した場合、全領域がアクセス可能になります。また、開始アドレスに終了アドレスより大きい値を指定しないでください。

• Page 1108, 1109 of 1244

「35.4.11 フラッシュ処理開始アドレスレジスタ H (FSARH)」、「35.4.13 フラッシュ処理終了アドレスレジスタ H (FEARH)」の説明文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

(省略)

このレジスタにはフラッシュメモリのアドレスの**b19-b16**を設定します。

(省略)

【訂正後】

(省略)

このレジスタにはフラッシュメモリの**プログラム/イレーズ用**アドレスの**b19-b16**を設定します。

(省略)

• Page 1109, 1110 of 1244

「35.4.12 フラッシュ処理開始アドレスレジスタ L (FSARL)」、「35.4.14 フラッシュ処理終了アドレスレジスタ L (FEARL)」の説明文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

(省略)

このレジスタにはフラッシュメモリのアドレスのb15-b0を設定します。

(省略)

【訂正後】

(省略)

このレジスタにはフラッシュメモリの**プログラム/イレーズ用**アドレスのb15-b0を設定します。

(省略)

• Page 1112 of 1244

「35.4.19 フラッシュステータスレジスタ 0 (FSTATR0)」の予約ビットの記載を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
(省略)				
b2	—	予約ビット	読むと“0”が読めます	R
(省略)				
b6	—	予約ビット	読むと“0”が読めます	R
b7	—	予約ビット	読んだ場合、その値は不定	R

【訂正後】

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
(省略)				
b2	—	予約ビット	読んだ場合、その値は不定	R
(省略)				
b7-b6	—	予約ビット	読んだ場合、その値は不定	R

• Page 1112 of 1244

「35.4.19 フラッシュステータスレジスタ 0 (FSTATR0)」の PRGERR フラグの説明文にある以下の文章を削除いたします。

イレーズ中に FCR.STOP = 1 (強制処理停止) するとフラグのリード値は不定になります。

•Page 1113 of 1244

「35.4.19 フラッシュステータスレジスタ 0 (FSTATR0)」のBCERRフラグの説明文に以下の文章を追加いたします。

ブランクチェック中にFCR.STOPビットを“1”（強制処理停止）にするとフラグの値は不定になります。

•Page 1114 of 1244

「35.4.20 フラッシュステータスレジスタ 1 (FSTATR1)」のFRDYフラグの説明文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

ソフトウェアコマンドの実行状態を確認するためのフラグです。

実行したソフトウェアコマンドの処理が完了すると“1”になり、FCR.OPSTビットを“0”にすると、“0”になります。

【訂正後】

ソフトウェアコマンドの実行状態を確認するためのフラグです。

実行したソフトウェアコマンドの処理が完了する**か、または強制停止処理が完了すると**“1”になり、FCR.OPSTビットを“0”にすると、“0”になります。

•Page 1115 of 1244

「35.4.21 フラッシュエラーアドレスモニタレジスタH (FEAMH)」の説明文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

ソフトウェアコマンドのうち、プログラム、ブロックイレーズ、ベリファイを実行中にエラーが発生した場合、エラーが発生したフラッシュメモリのアドレスが格納されます。ブランクチェックコマンドを実行し、ブランクチェックエラーが発生した場合は、書き込みが行われていたフラッシュメモリのアドレスが格納されます。

(省略)

【訂正後】

ソフトウェアコマンドの処理中にエラーが発生した場合、フラッシュメモリのエラー発生アドレスを確認するためのレジスタです。エラーが発生したアドレスのb19-b16 (プログラムコマンド、ブランクチェックコマンド)、または、エラーが発生した領域の先頭アドレスのb19-b16 (ブロックイレーズコマンド)が格納されます。

なお、FRESETR.FRESETビットを“1”にすると不定になりますので、エラー処理を行う際はリセット前に値を読み出しておいてください。

(省略)

• Page 1115 of 1244

「35.4.22 フラッシュエラーアドレスモニタレジスタ L (FEAML)」の説明文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

ソフトウェアコマンドの処理中にエラーが発生した場合、フラッシュメモリのエラー発生アドレスを確認するためのレジスタです。エラーが発生した**フラッシュメモリ**のアドレスのb15-b0、または、エラーが発生した**フラッシュメモリ**の領域の先頭アドレスのb15-b0が格納されます。

ソフトウェアコマンドが正常に終了した場合は、コマンド実行時の最終アドレスのb15-b0が格納されず。

なお、ROM領域を設定する場合、b1-b0は“00b”を設定してください。

ROMに対するソフトウェアコマンドを実行した場合は、下位2ビットが“00b”になります。

フラッシュメモリのアドレスは、図35.1、図35.2を参照してください。

【訂正後】

ソフトウェアコマンドの処理中にエラーが発生した場合、フラッシュメモリのエラー発生アドレスを確認するためのレジスタです。エラーが発生したアドレスのb15-b0 (**プログラムコマンド、ブランクチェックコマンド**)、または、エラーが発生した領域の先頭アドレスのb15-b0 (**ブロックイレーズコマンド**)が格納されます。

なお、FRESETR.FRESETビットを“1”にすると不定になりますので、エラー処理を行う際はリセット前に値を読み出しておいてください。

ソフトウェアコマンドが正常に終了した場合は、コマンド実行時の最終アドレスのb15-b0が格納されず。

なお、ROMに対するソフトウェアコマンドを実行した場合、**およびユニークIDリードコマンドを実行した場合**、下位2ビットは“00b”になります。

フラッシュメモリのアドレスは、図35.1、図35.2を参照してください。

• Page 1116 of 1244

「35.4.24 フラッシュアクセスウィンドウ開始アドレスモニタレジスタ (FAWSMR)」の注1本文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

- 注1. ブランク品は“1”です。アクセスウィンドウ情報プログラムコマンドを実行した後は、FWBHレジスタのb9-b0に設定した値と同じ値になります。

【訂正後】

- 注1. ブランク品は“1”です。アクセスウィンドウ情報プログラムコマンドを実行した後は、FWBLレジスタのb9-b0に設定した値と同じ値になります。

• Page 1117 of 1244

「35.4.25 フラッシュアクセスウィンドウ終了アドレスモニタレジスタ (FAWEMR)」の注1本文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

- 注1. ブランク品は“1”です。アクセスウィンドウ情報プログラムコマンドを実行した後は、FWBLレジスタのb9-b0に設定した値と同じ値になります。

【訂正後】

- 注1. ブランク品は“1”です。アクセスウィンドウ情報プログラムコマンドを実行した後は、FWBHレジスタのb9-b0に設定した値と同じ値になります。

• Page 1118 of 1244

「35.5 スタートアッププログラム保護機能」の図35.3の(2)本文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

- (2) 代替領域の書き換えが成功したら、セルフプログラミングを使用して、デフォルト領域と代替領域の配置を入れ替えます。これ以降、リセット後は代替領域からプログラムが起動します。

【訂正後】

- (2) 代替領域の書き換えが成功したら、スタートアップ領域情報プログラムコマンドを使用して、デフォルト領域と代替領域の配置を入れ替えます。これ以降、リセット後は代替領域からプログラムが起動します。

• Page 1119 of 1244

「35.6 エリアプロテクション」の本文、および図35.4を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

アクセスウィンドウの範囲設定は、**スタートブロックとエンドブロック**を指定して行います。アクセスウィンドウの範囲は、ブートモードおよびセルフプログラミングのいずれでも設定できますが、エリアプロテクションが有効になるのはシングルチップモードでセルフプログラミングを行うときだけです。

図35.4にエリアプロテクションの概念を示します。

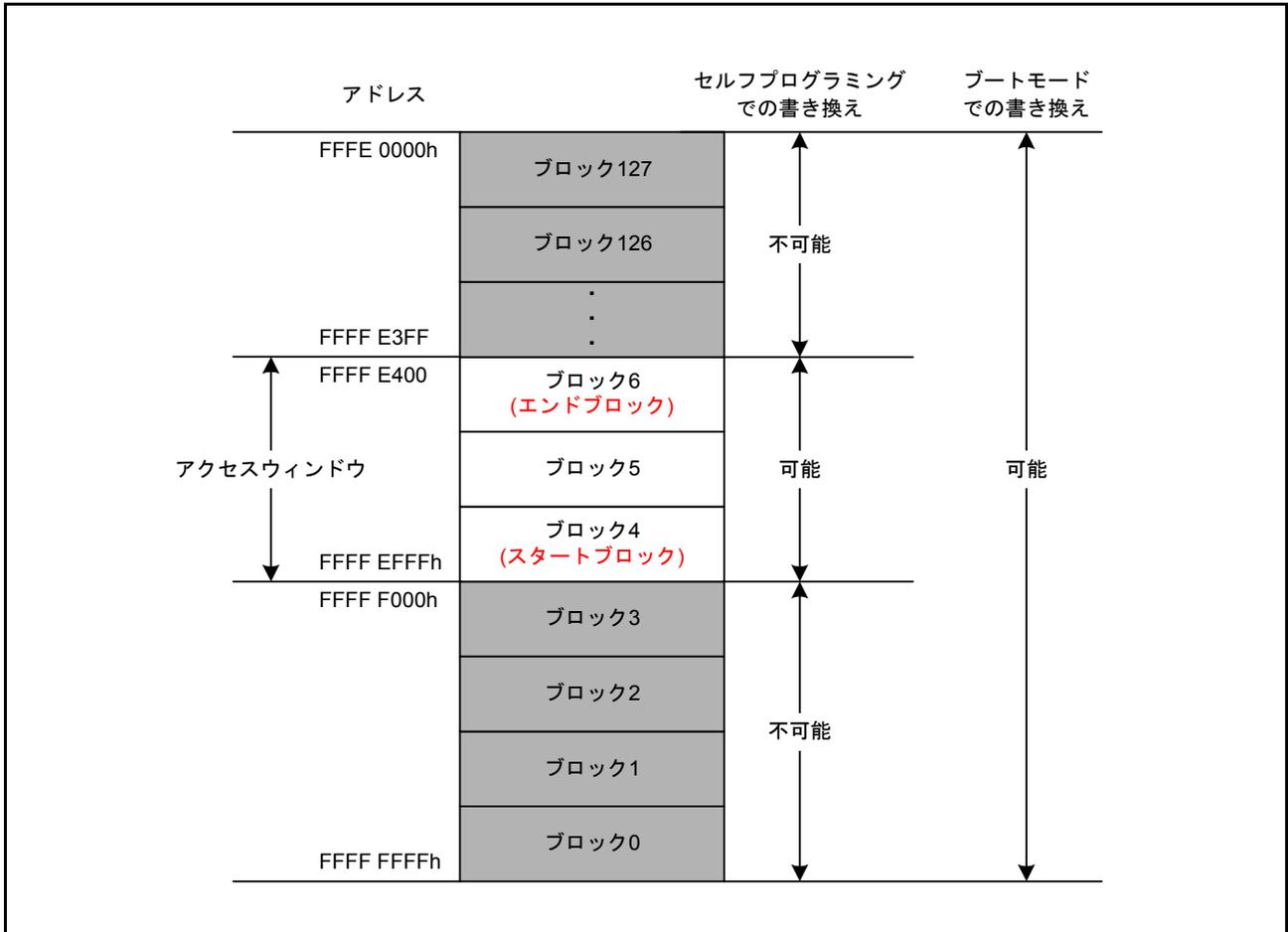


図35.4 エリアプロテクションの概念 (ブロック4からブロック6をアクセスウィンドウに設定)

【訂正後】

アクセスウィンドウの範囲設定は、**開始アドレス**と**終了アドレス**を指定して行います。アクセスウィンドウの範囲は、ブートモードおよびセルフプログラミングのいずれでも設定できますが、エリアプロテクションが有効になるのはシングルチップモードでセルフプログラミングを行うときだけです。

図35.4にエリアプロテクションの概念を示します。

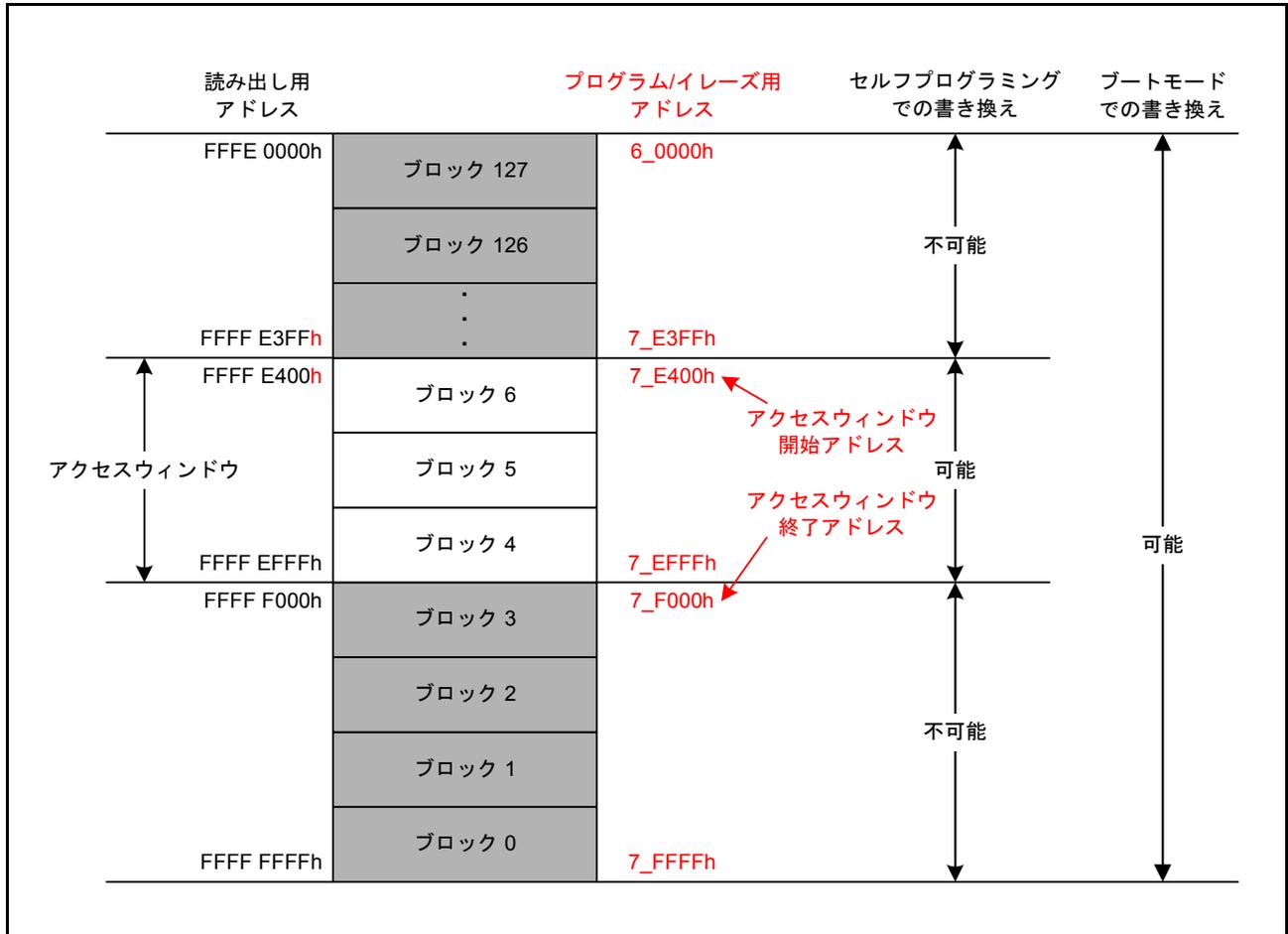


図35.4 エリアプロテクションの概念 (ブロック4からブロック6をアクセスウィンドウに設定)

• Page 1120, 1121 of 1244

「35.7.1 シーケンサのモード」の本文、および図35.5を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

シーケンサには、3種類のモードがあります。モードの移行は、FENTRYRレジスタへの書き込み、およびソフトウェアコマンドで行います。図35.5にフラッシュメモリのモード遷移図を示します。

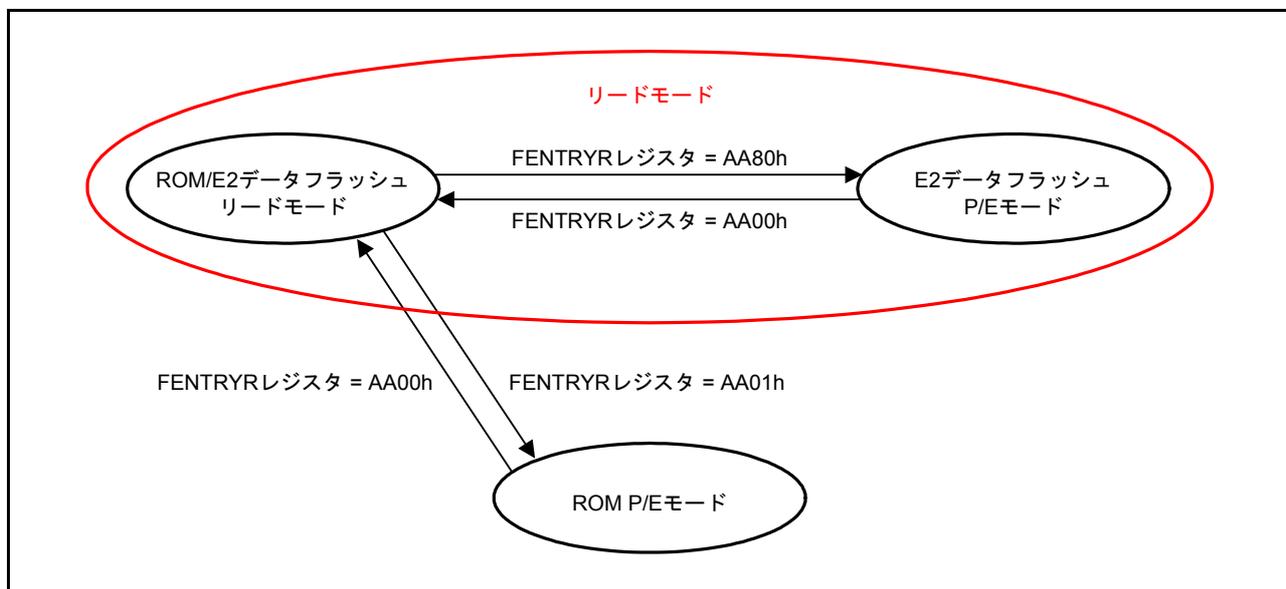


図35.5 フラッシュメモリのモード遷移図

35.7.1.1 リードモード

リードモードは、ROM/E2データフラッシュの高速読み出しを行うためのモードです。読み出し用アドレスに対してリードアクセスを実行した場合、11CLKクロックの高速読み出しが可能です。

リードモードには、ROM/E2データフラッシュリードモードがあります。

(1) ROM/E2データフラッシュリードモード

ROM/E2データフラッシュリードモードは、ROMおよびE2データフラッシュの読み出しが可能なモードです。FENTRYR.FENTRY0ビットを“0”、かつFENTRYR.FENTRYDビットを“0”にした場合にこのモードに移行します。

なお、E2データフラッシュにアクセスする場合は、さらにDFLCTL.DFLENビットを“1”に設定してください。

35.7.1.2 P/Eモード

P/Eモードには、ROM P/Eモードと、E2データフラッシュ P/Eモードの2種類あります。

(1) ROM P/Eモード

ROM P/Eモードは、ROMへのプログラム/イレーズを行うモードです。FENTRYR.FENTRYDビットを“0”、かつFENTRYR.FENTRY0ビットを“1”にした場合にこのモードに移行します。

(2) E2データフラッシュ P/Eモード

E2データフラッシュ P/Eモードは、E2データフラッシュに対するプログラム/イレーズを行うモードです。ROMの高速読み出しは可能です。FENTRYR.FENTRY0ビットを“0”、かつFENTRYR.FENTRYDビットを“1”にした場合にこのモードに移行します。

なお、E2データフラッシュにアクセスする場合は、さらにDFLCTL.DFLENビットを“1”に設定してください。

【訂正後】

シーケンサには、4種類のモードがあります。モードの移行は、DFLCTLレジスタ、FENTRYRレジスタへの書き込み、およびFPMCRレジスタの設定で行います。図35.5にフラッシュメモリのモード遷移図を示します。

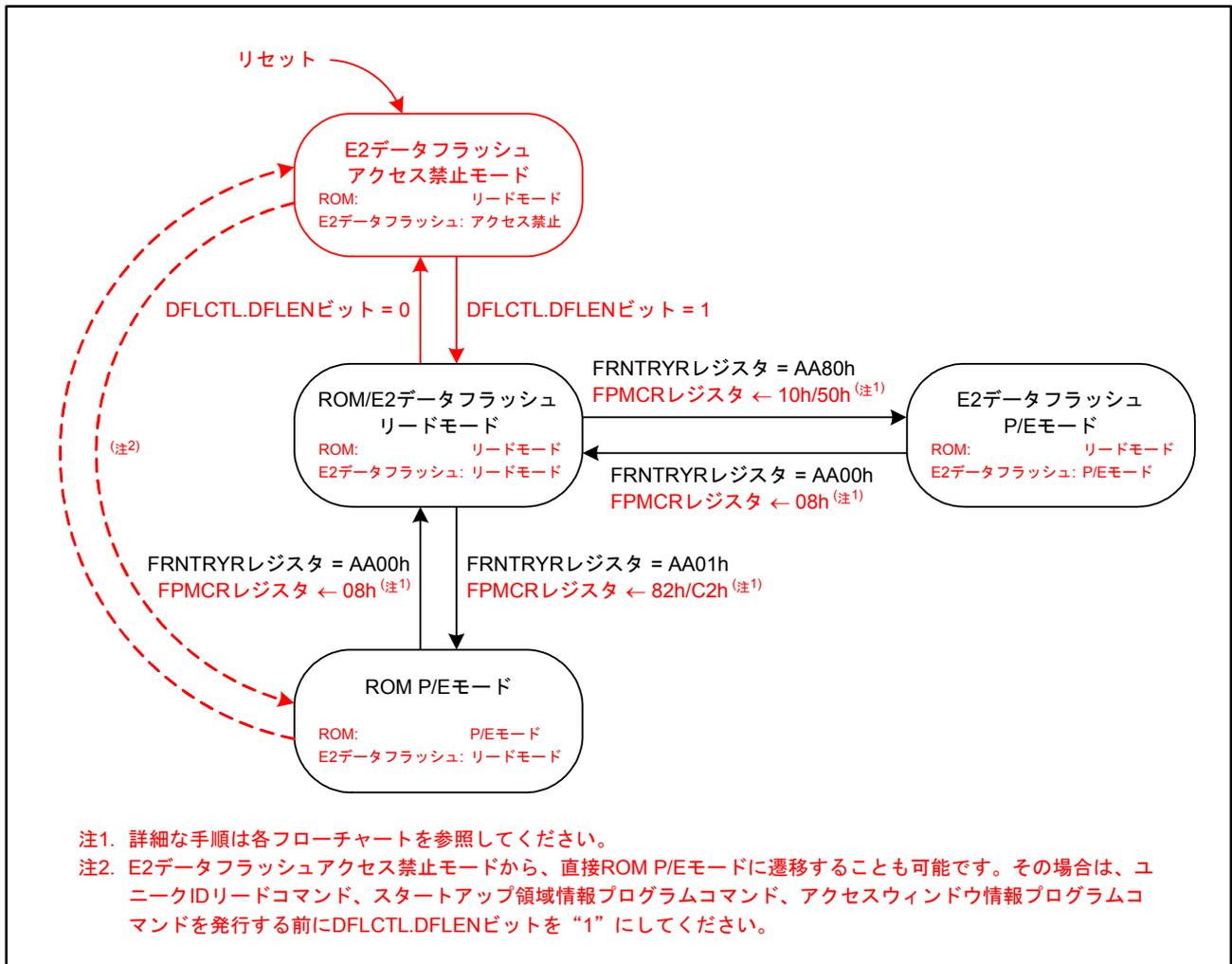


図35.5 フラッシュメモリのモード遷移図

35.7.1.1 E2データフラッシュアクセス禁止モード

E2データフラッシュアクセス禁止モードは、E2データフラッシュのアクセスが禁止されているモードです。リセット直後はこのモードに遷移します。

DFLCTL.DFLENビットを“1”にすると、E2データフラッシュはリードモードに遷移します。

35.7.1.2 リードモード

リードモードは、ROMまたはE2データフラッシュの高速読み出しを行うためのモードです。読み出し用アドレスに対してリードアクセスを実行した場合、1ICLKクロックの高速読み出しが可能です。

(1) ROM/E2データフラッシュリードモード

ROM、E2データフラッシュともにリードモードになっているモードを、ROM/E2データフラッシュリードモードと言います。P/Eモードからは、FPMCRレジスタを“08h”、FENTRYR.FENTRYDビットを“0”、FENTRYR.FENTRY0ビットを“0”にした場合にこのモードに遷移します。

35.7.1.3 P/Eモード

P/Eモードは、ROMまたはE2データフラッシュのプログラム/イレーズを行うモードです。

(1) ROM P/Eモード

ROMがP/Eモード、E2データフラッシュがリードモードになっているモードを、ROM P/Eモードと言います。FENTRYR.FENTRYDビットを“0”、FENTRYR.FENTRY0ビットを“1”、FPMCRレジスタを“82h”または“C2h”にした場合にこのモードに遷移します。

(2) E2データフラッシュ P/Eモード

ROMがリードモード、E2データフラッシュがP/Eモードになっているモードを、E2データフラッシュ P/Eモードと言います。FENTRYR.FENTRYDビットを“1”、FENTRYR.FENTRY0ビットを“0”、FPMCRレジスタを“10h”または“50h”にした場合にこのモードに遷移します。

• Page 1122 of 1244

「35.7.3 ソフトウェアコマンド使用方法」の「(1) ROM P/Eモード移行方法」の図35.6を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

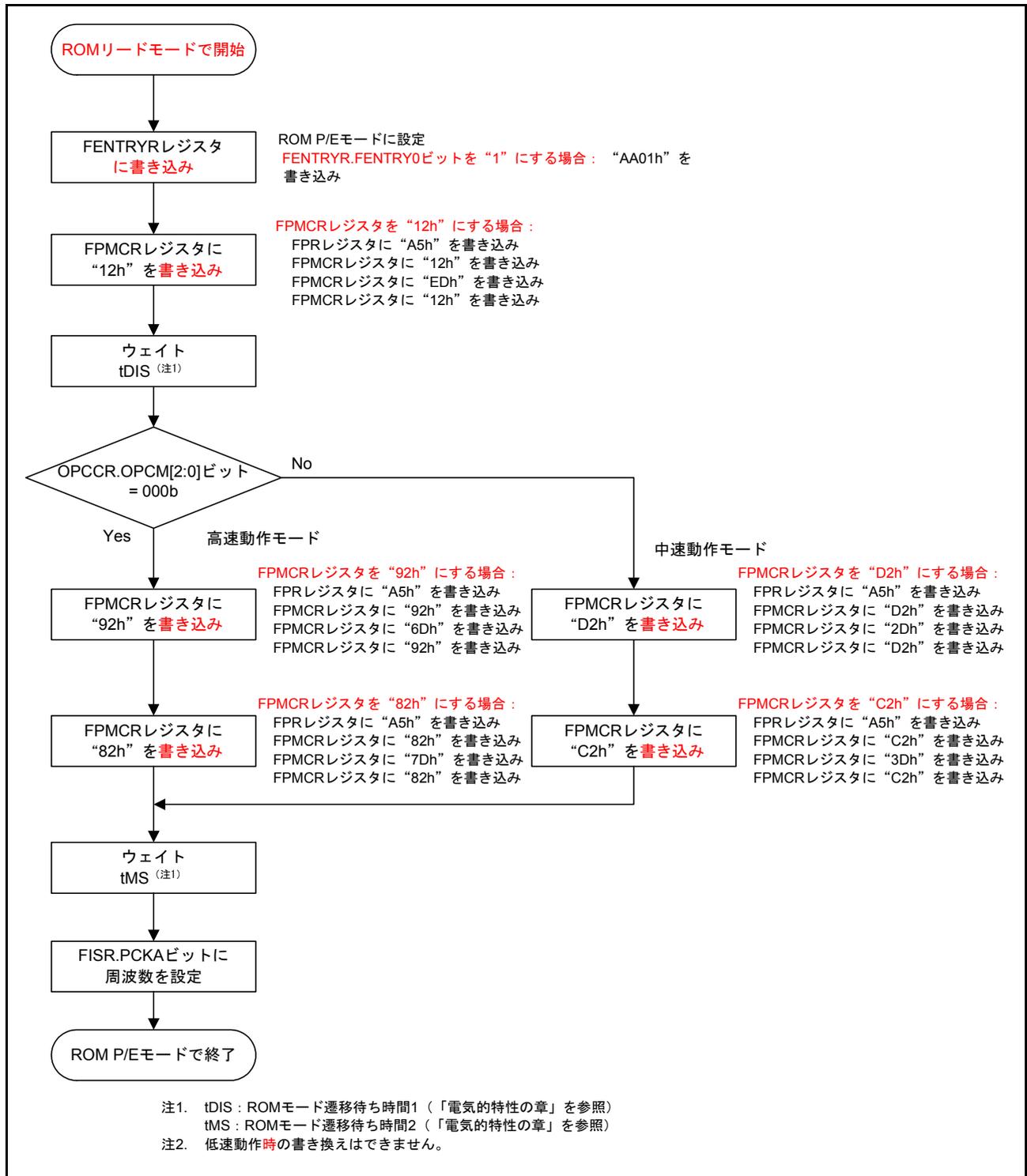


図 35.6 ROM P/Eモード移行フロー

【訂正後】

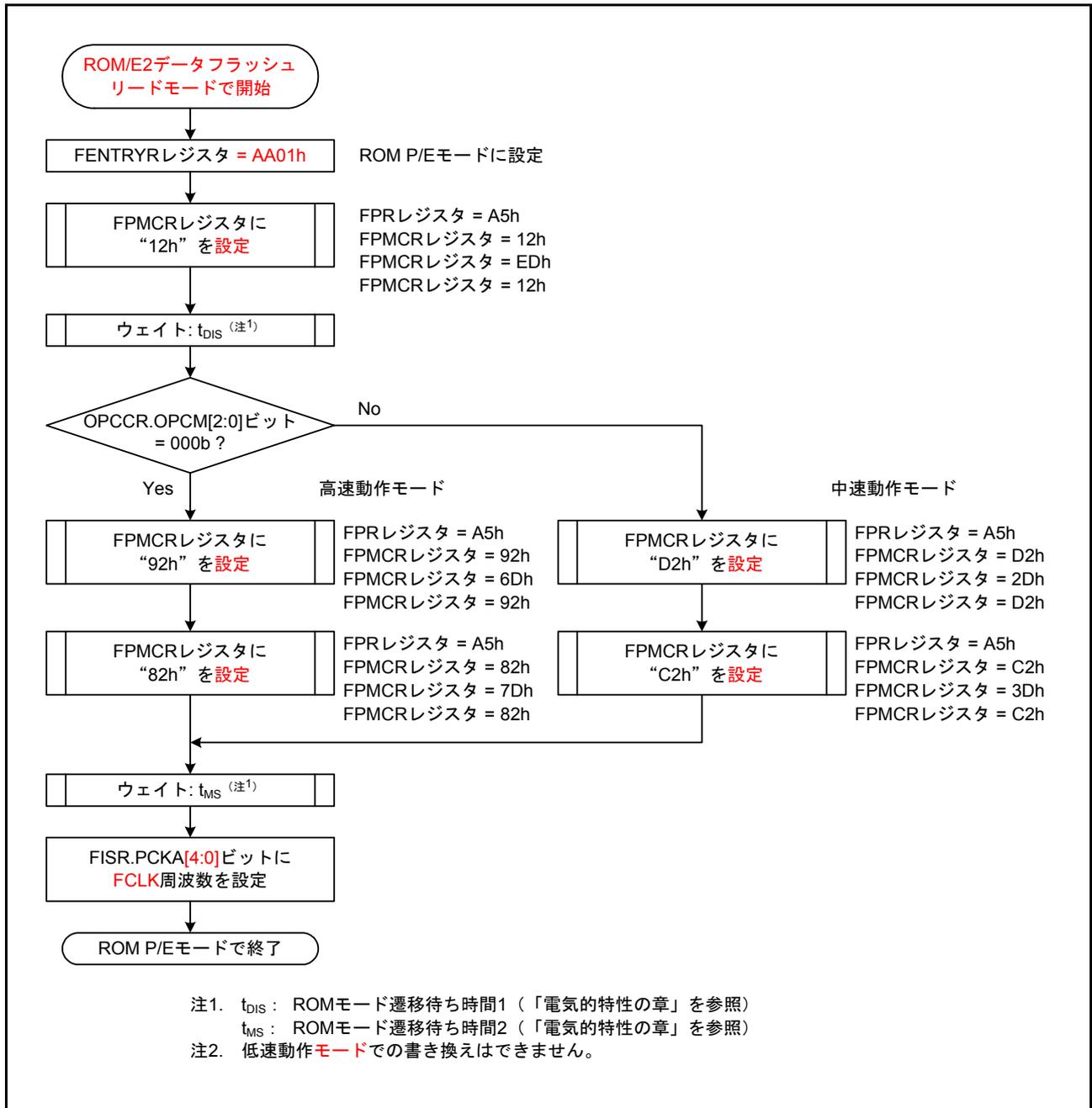


図 35.6 ROM/E2データフラッシュリードモードからROM P/Eモードへの遷移フロー

• Page 1123 of 1244

「35.7.3 ソフトウェアコマンド使用方法」の「(1) ROM P/Eモード移行方法」の図35.7を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

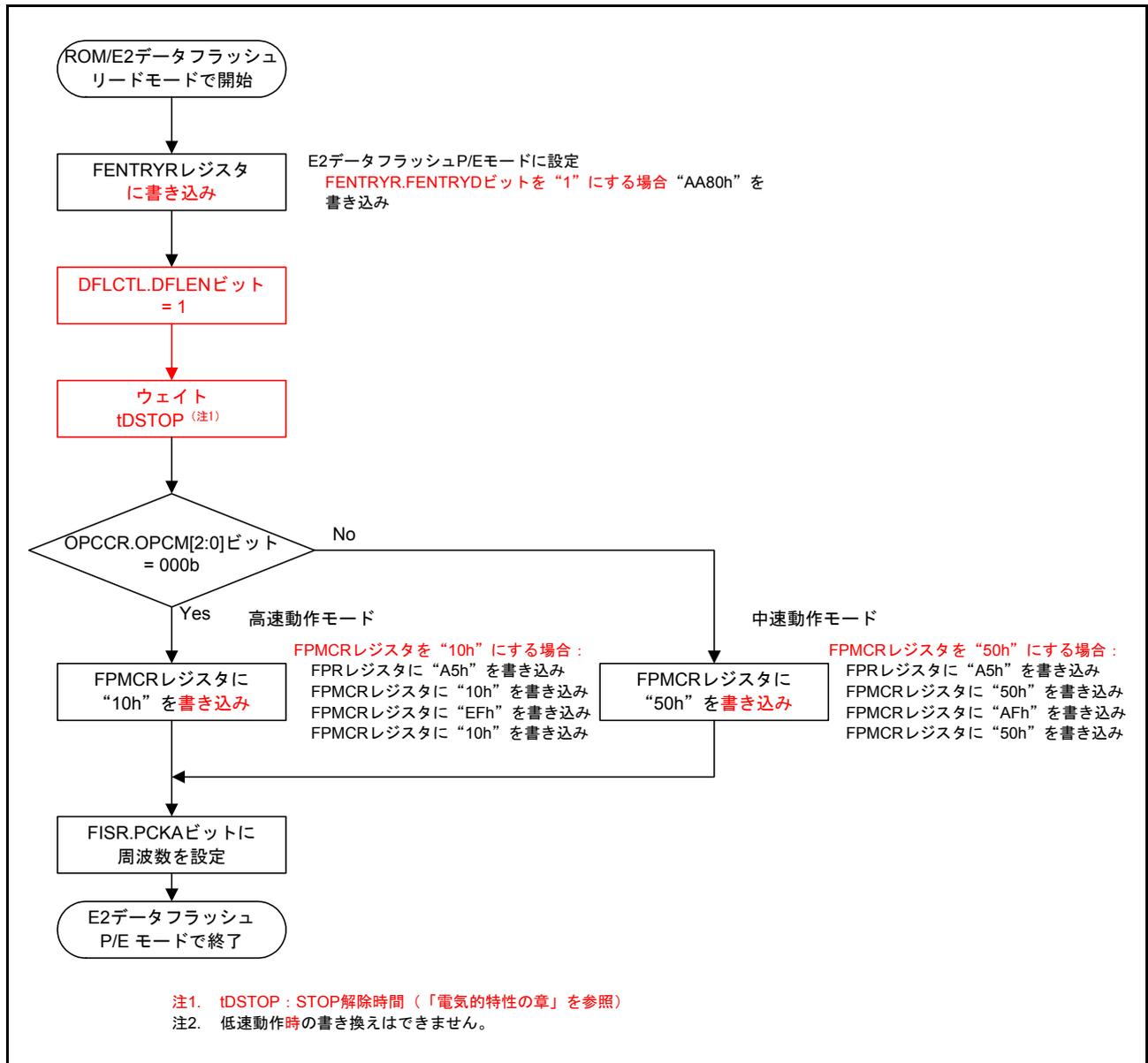


図35.7 ROM/E2データフラッシュリードモードからE2データフラッシュ P/Eモードへの遷移フロー

【訂正後】

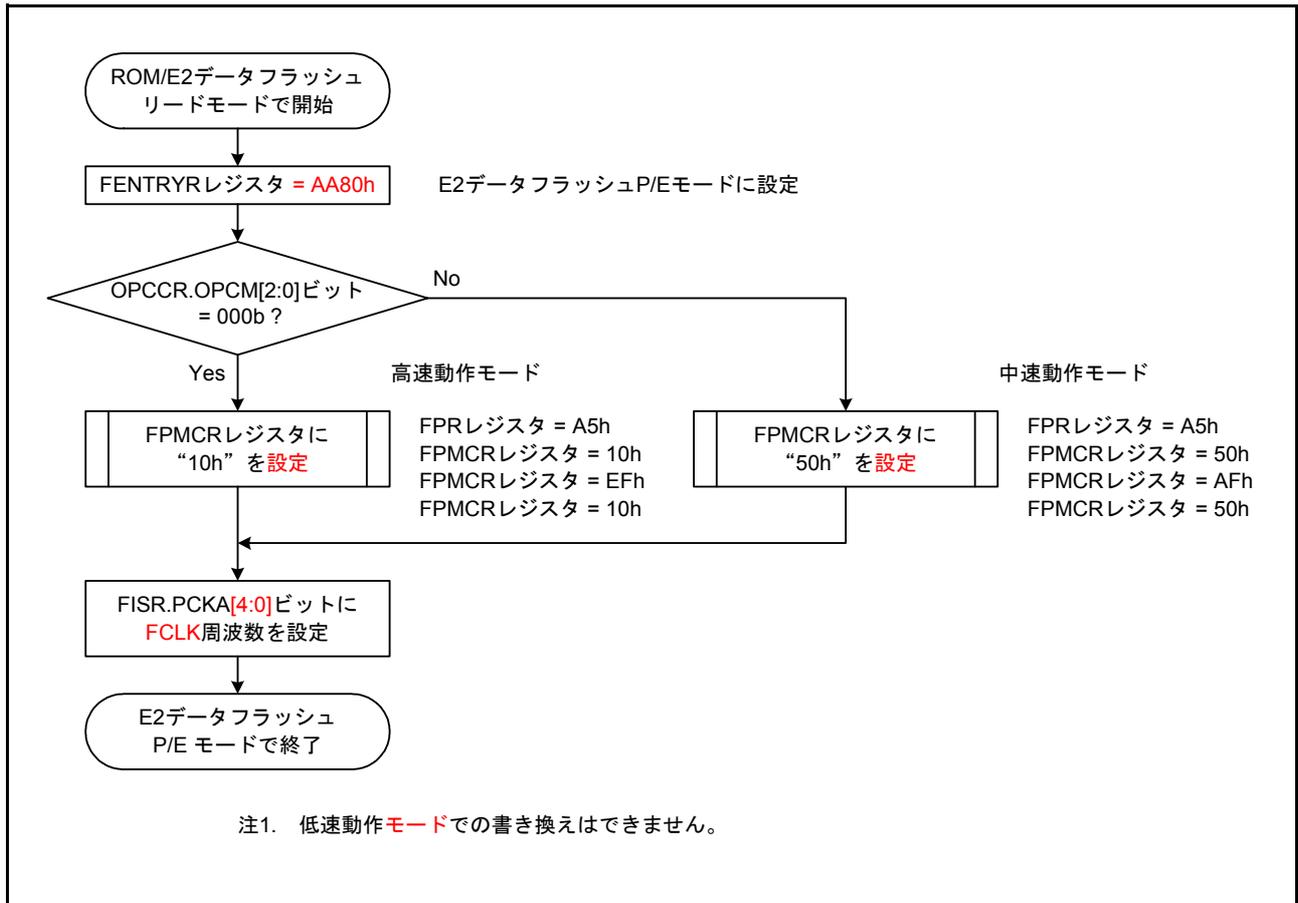


図 35.7 ROM/E2データフラッシュリードモードからE2データフラッシュ P/Eモードへの遷移フロー

• Page 1124 of 1244

「35.7.3 ソフトウェアコマンド使用方法」の「(2) ROMリードモード移行方法」の図35.8を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

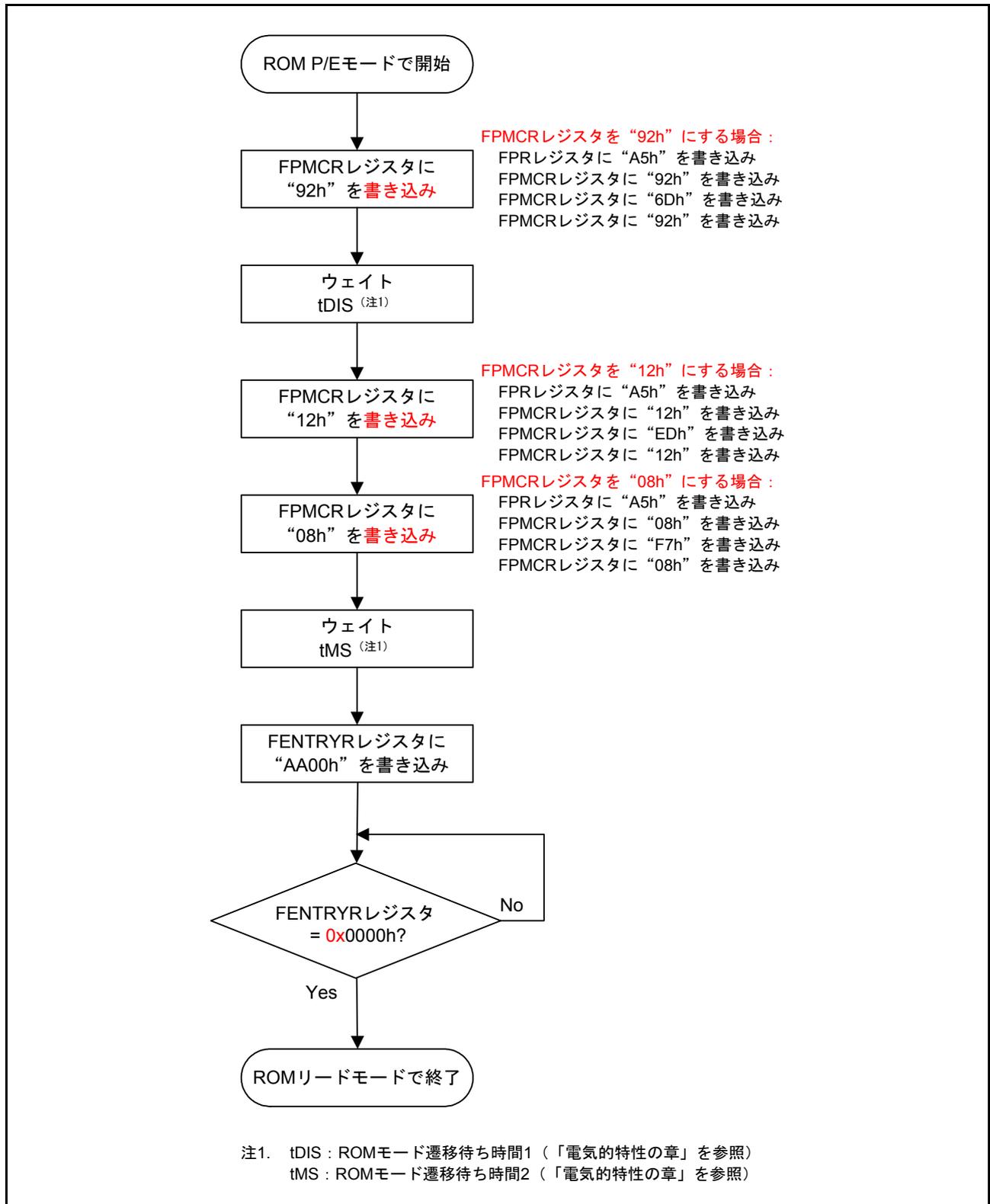


図35.8 ROMリードモード遷移フロー

【訂正後】

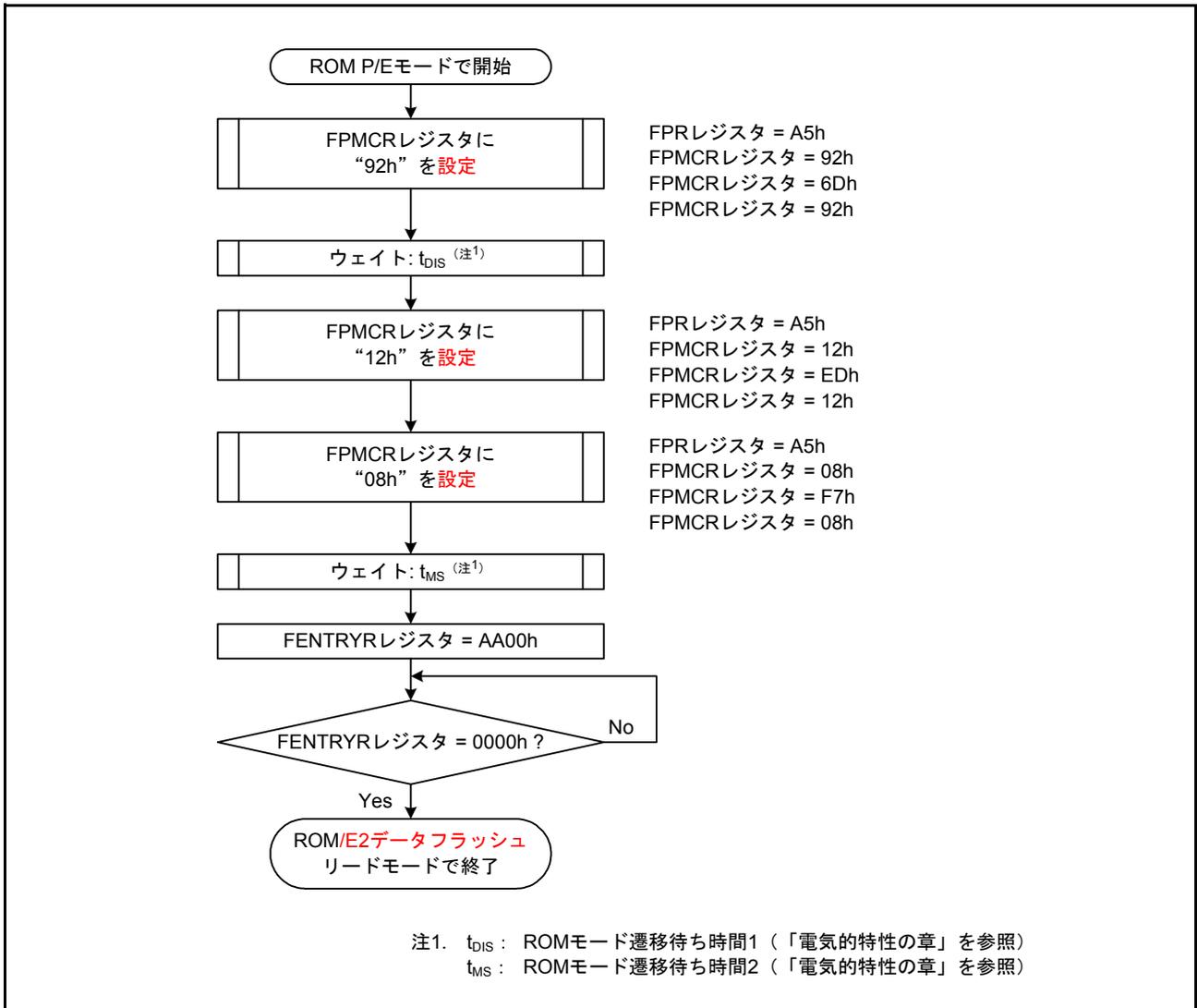


図 35.8 ROM P/EモードからROM/E2データフラッシュリードモードへの遷移フロー

• Page 1125 of 1244

「35.7.3 ソフトウェアコマンド使用方法」の「(2) ROM リードモード移行方法」の図 35.9 を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

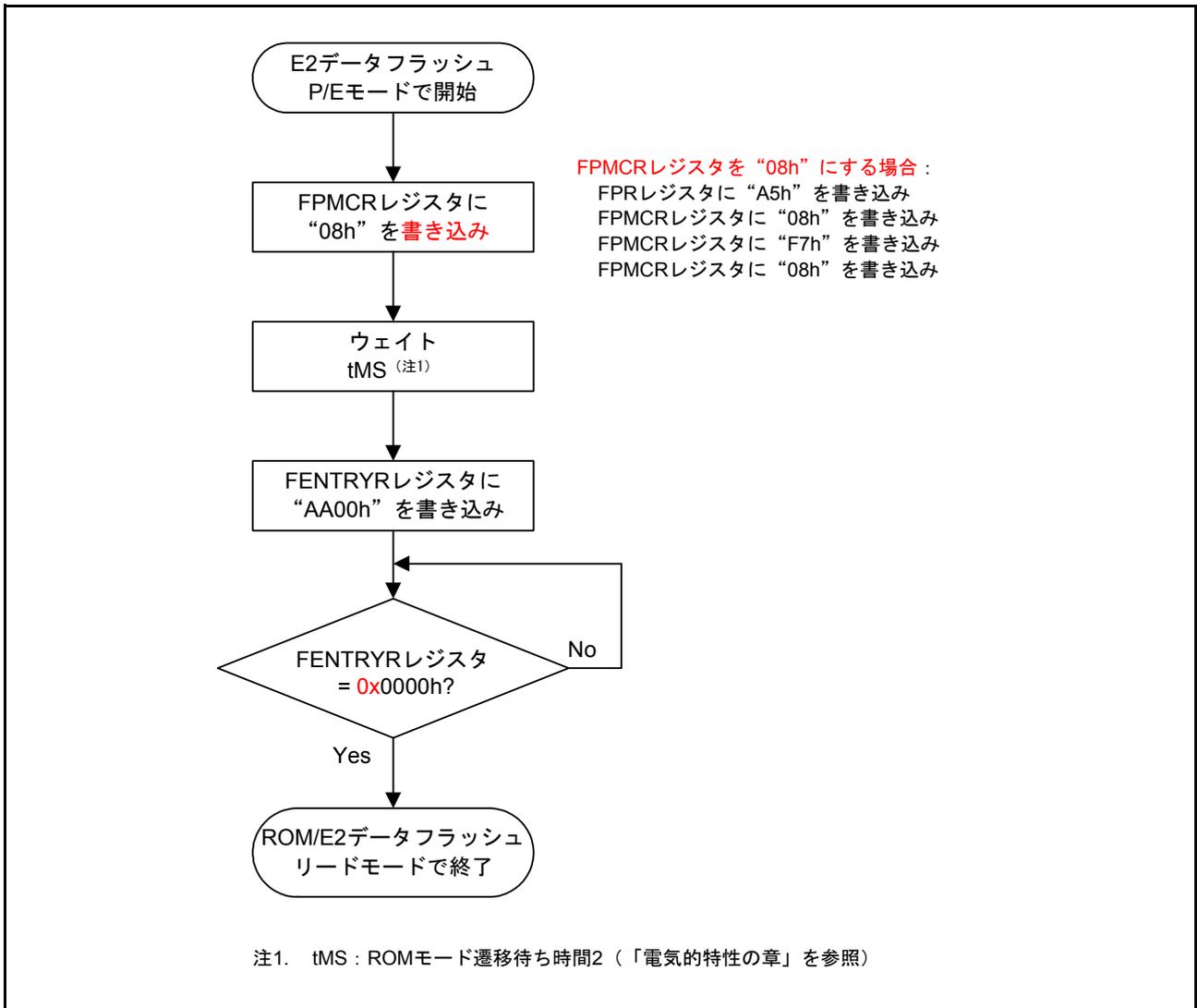


図 35.9 E2データフラッシュ P/EモードからROM/E2データフラッシュリードモードへの遷移フロー

【訂正後】

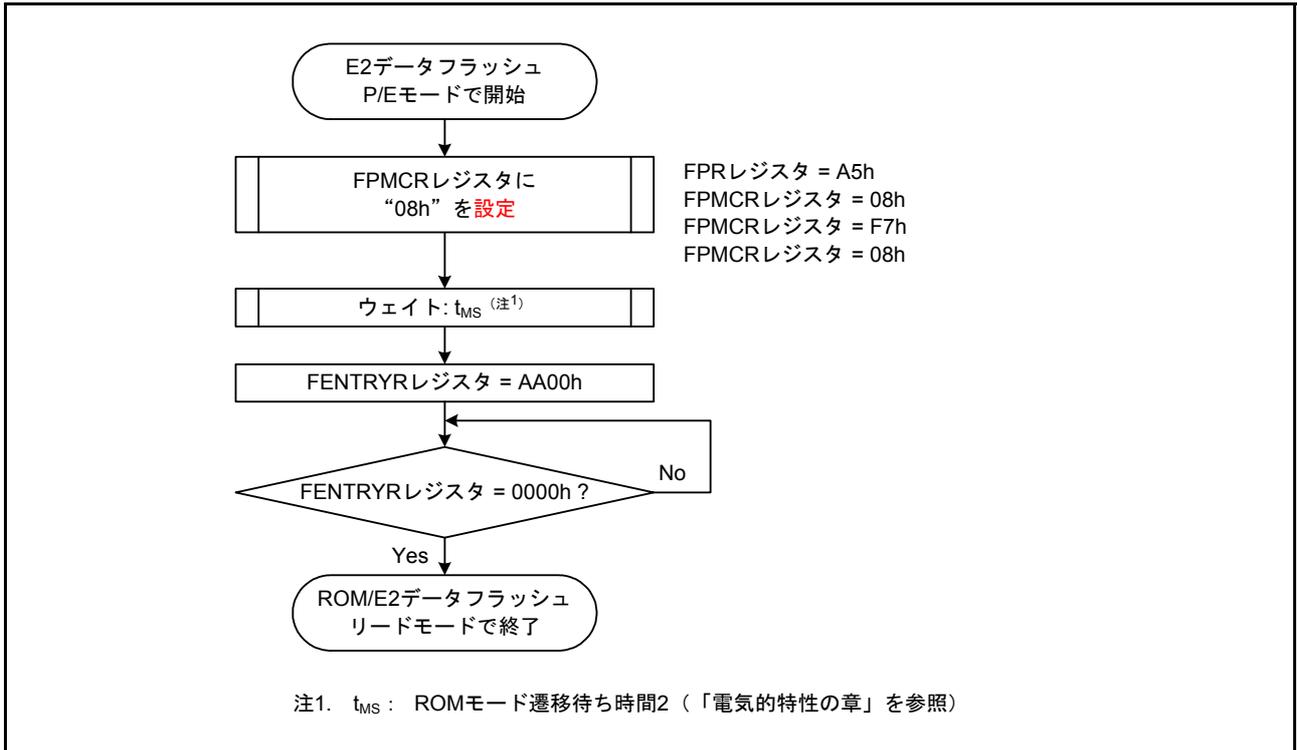


図35.9 E2データフラッシュ P/EモードからROM/E2データフラッシュリードモードへの遷移フロー

• Page 1120 to 1133 of 1244

「35.7 プログラム/イレーズ」の章構成を以下のとおり変更いたします。

【変更前】

- 35.7 プログラム/イレーズ
- 35.7.1 シーケンサのモード
 - 35.7.1.1 リードモード
 - 35.7.1.2 P/Eモード
- 35.7.2 ソフトウェアコマンド一覧
- 35.7.3 ソフトウェアコマンド使用方法
 - (1) ROM P/Eモード移行方法
 - (2) ROM リードモード移行方法
 - (3) プログラム/イレーズ方法手順
 - (4) スタートアップ領域情報プログラム/アクセスウィンドウ情報プログラム
 - (5) 連続リード

【変更後】

- 35.7 プログラム/イレーズ
- 35.7.1 シーケンサのモード
 - 35.7.1.1 E2データフラッシュアクセス禁止モード
 - 35.7.1.2 リードモード
 - 35.7.1.3 P/Eモード
- 35.7.2 モード遷移
 - 35.7.2.1 E2データフラッシュアクセス禁止モードからリードモードへの遷移
 - 35.7.2.2 リードモードからP/Eモードへの遷移
 - 35.7.2.3 P/Eモードからリードモードへの遷移
- 35.7.3 ソフトウェアコマンド一覧
- 35.7.4 ソフトウェアコマンド使用方法
 - 35.7.4.1 プログラム
 - 35.7.4.2 ブロックイレーズ
 - 35.7.4.3 ブランクチェック
 - 35.7.4.4 スタートアップ領域情報プログラム/アクセスウィンドウ情報プログラム
 - 35.7.4.5 ユニークIDリード
 - 35.7.4.6 ソフトウェアコマンドの強制停止

また、追加した「35.7.2.1 E2データフラッシュアクセス禁止モードからリードモードへの遷移」に下記のフロー図を追加いたします。

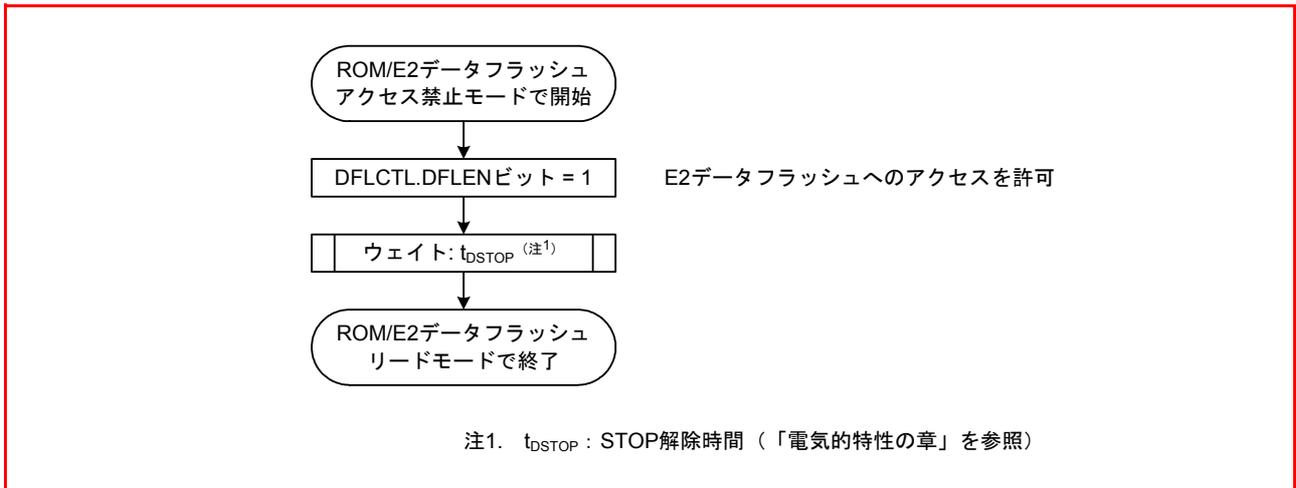


図35.x E2データフラッシュアクセス禁止モードからROM/E2データフラッシュリードモードへの遷移フロー

また、追加した「35.7.4.6 ソフトウェアコマンドの強制停止」に下記の本文とフロー図を追加いたします。

35.7.4.6 ソフトウェアコマンドの強制停止

ブランクチェックコマンド、ブロックイレーズコマンドを強制的に停止させるには図35.xxに従って実施してください。

強制停止を実行すると、FEAMH/FEAMLレジスタに中断した時点のアドレスが格納されます。ブランクチェックの場合は、FEAMH/FEAMLレジスタの値をFSARH/FSARLレジスタにコピーすることで、中断した処理を続きから再開させることができます。

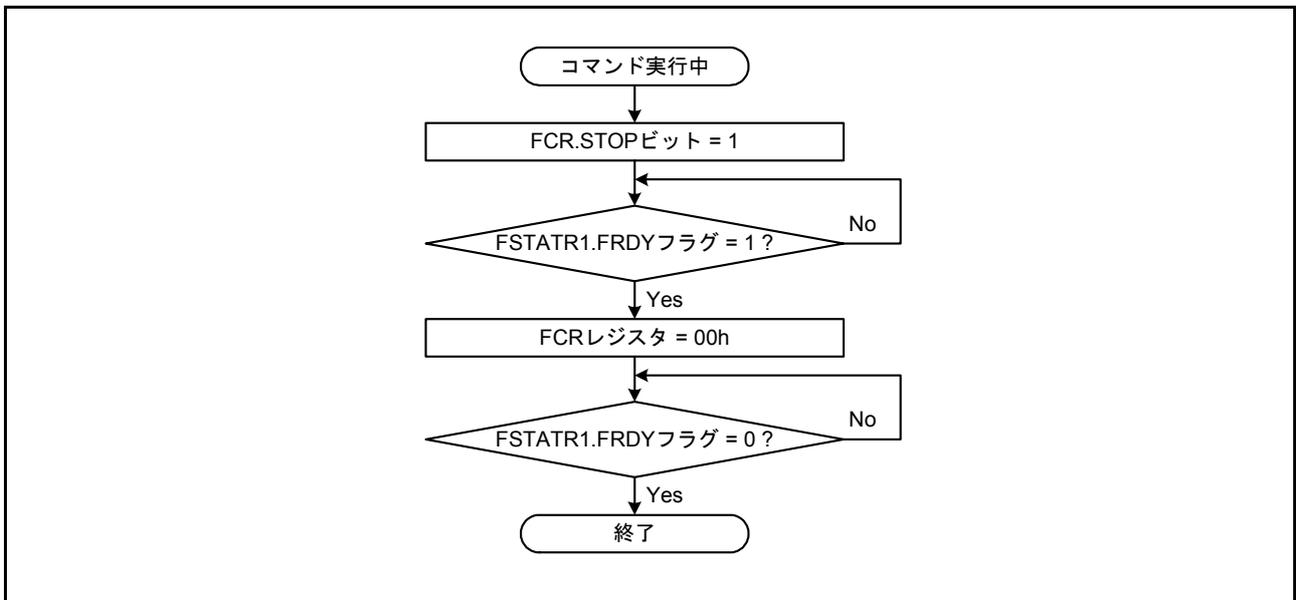


図35.xx ソフトウェアコマンド強制停止の実行フロー

• Page 1154 of 1244

「35.10.6 動作周波数選択」を以下のとおり「35.10.5.2」に訂正いたします。また、以降の項番号も併せて訂正いたします。

【訂正前】

- 35.10.6 動作周波数選択
- 35.10.6.1 プログラム/イレーズステータス遷移
- 35.10.7 IDコード認証コマンド
- :

【訂正後】

- 35.10.5.2 動作周波数選択
- 35.10.5.3 プログラム/イレーズステート遷移
- 35.10.6 IDコード認証コマンド
- :

• Page 1177 of 1244

「35.11 セルフプログラミングでの書き換え」の「35.11.1 概要」本文、および図35.38を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

本MCUは、ユーザプログラム自身によるフラッシュメモリの書き換えをサポートします。ルネサスエレクトロニクスが提供するコードフラッシュライブラリとデータフラッシュライブラリをユーザのプログラムで使用することにより、ROMとE2データフラッシュを書き換えることができます。

E2データフラッシュの書き換え時には、BGO機能を利用してROM上の書き換え用のプログラムを実行して、E2データフラッシュを書き換えることができます。また、あらかじめ内蔵RAMに転送した書き換え用のプログラムを実行して、E2データフラッシュを書き換えることもできます。

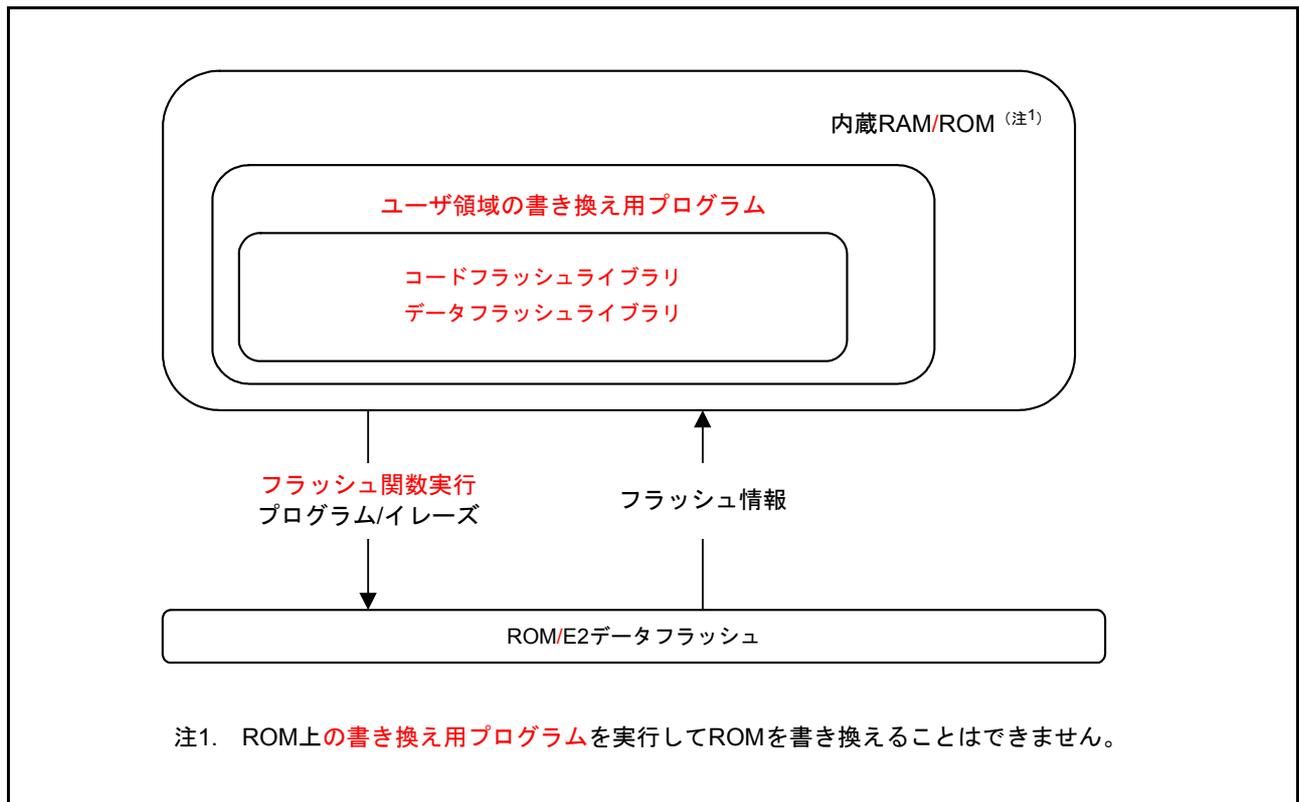


図35.38 セルフプログラミングの概念

フラッシュセルフプログラミングに関する包括的な情報は、本デバイスの対象となる「コードフラッシュライブラリ」と「データフラッシュライブラリ」のユーザーズマニュアルを参照してください。

【訂正後】

本MCUは、ユーザプログラム自身によるフラッシュメモリの書き換えをサポートします。ユーザプログラム内にフラッシュ書き換えルーチンを用意することにより、ROMとE2データフラッシュを書き換えることができます。

E2データフラッシュは、BGO機能を利用してROM上でフラッシュ書き換えルーチンを実行して、書き換えることができます。また、あらかじめ内蔵RAMに転送したフラッシュ書き換えルーチンを実行して、E2データフラッシュを書き換えることもできます。

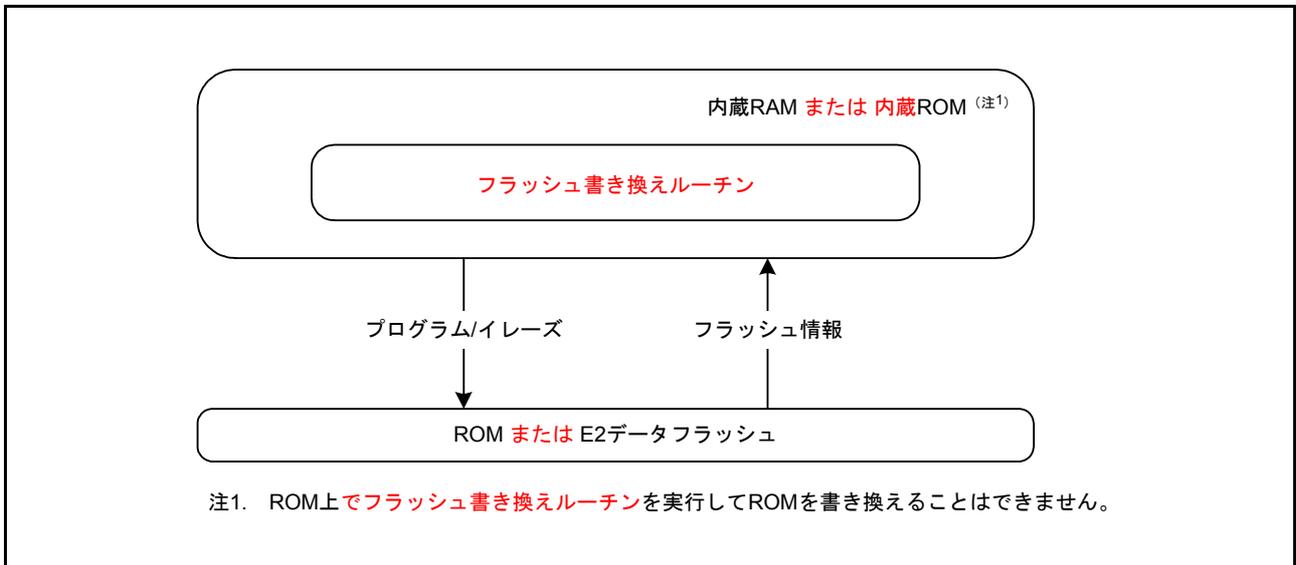


図 35.38 セルフプログラミングの概念

• Page 1178 of 1244

「35.12 使用上の注意事項」の(1)、(2)の説明文を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

- (1) イレーズサスペンド対象領域
イレーズサスペンド中の領域の格納データは不定です。不定データの読み出しが原因で発生する誤動作を回避するために、イレーズサスペンド対象領域の命令実行や、データ読み出しが発生しないように注意してください。
- (2) イレーズサスペンドによる中断
イレーズサスペンドコマンドによってイレーズ処理を中断した場合は、レジュームコマンドにより動作を完了させてください。

【訂正後】

- (1) イレーズ処理強制停止後の該当ブロックへのアクセス
イレーズ処理を強制停止した場合、処理が中断されたブロックの格納データは不定です。不定データの読み出しが原因で発生する誤動作を回避するために、当該ブロックでの命令実行や、データ読み出しが発生しないように注意してください。
- (2) イレーズ処理強制停止後の処理
イレーズ処理を強制停止した場合は、もう一度同一ブロックに対して、ブロックイレーズコマンドを発行してください。

以上